

**关键指标**

- 频率: DC~6GHz
- 插入损耗: 1.4dB
- 隔离度: 35dB
- 电压/电流: +5V/3mA
- 控制电平: 0/+3.3V, 0/+5V
- 芯片尺寸: 1.85mm×1.3mm×0.1mm

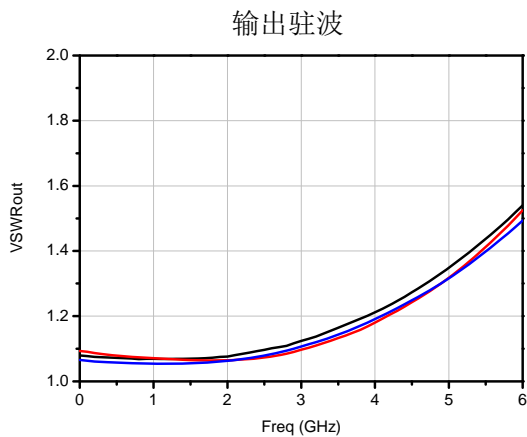
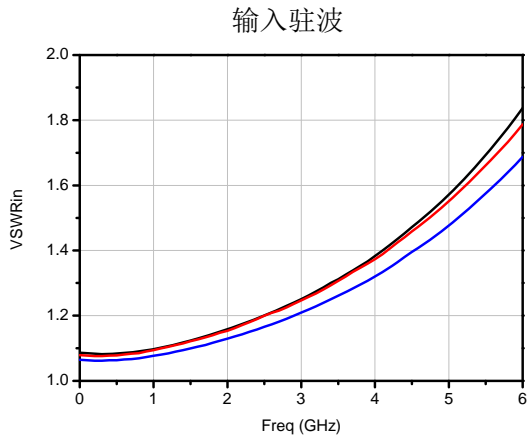
**产品简介**

HG133K-2/HG133K-2(M)是一款 DC~6GHz 吸收式单刀三掷开关芯片, 集成控制驱动器, 射频输入输出端需要外加隔直电容, +5V 单电源供电。

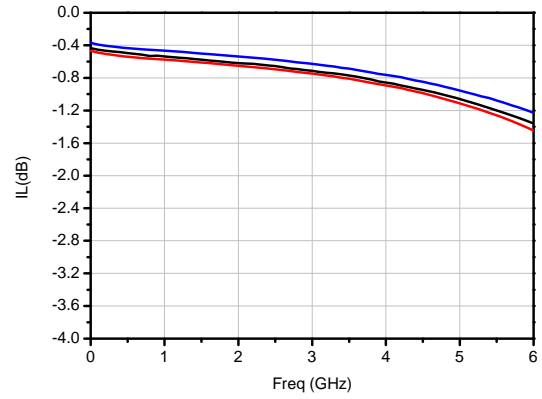
**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+5V)**

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~6		
输入驻波	-	1.6	-
输出驻波	-	1.4	-
插入损耗(dB)	-	1.4	-
隔离度(dB)	-	35	-
静态电流 (mA)	-	3	-

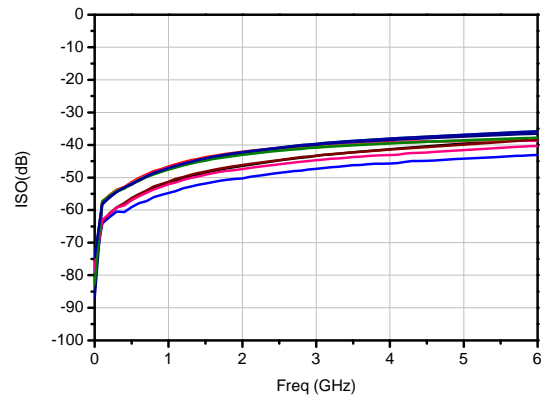
**典型测试曲线**



**插入损耗**



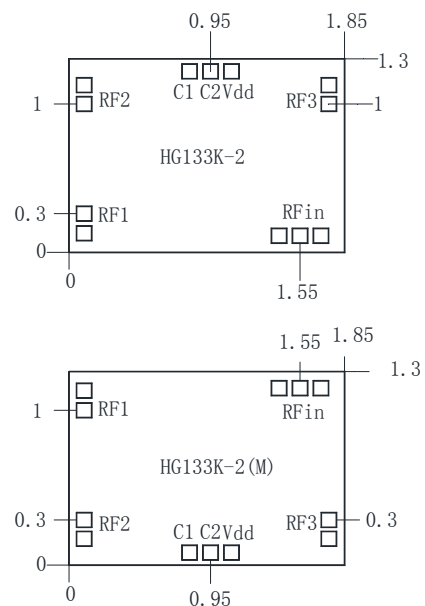
**隔离度**



**真值表(V<sub>dd</sub>=+5V)**

C2	C1	RFC-RF1	RFC-RF2	RFC-RF3
0V	0V	ON	OFF	OFF
0V	3V~5V	OFF	ON	OFF
3V~5V	0V	OFF	OFF	ON
3V~5V	3V~5V	OFF	OFF	OFF

**外形和端口尺寸 (mm)**



### 绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
工作电压	+5.5V	
控制电平	低电平：0~0.5V	高电平：3~5V
工作温度	-55℃~125℃	
存储温度	-65℃~150℃	

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。